

明 細 書

電極および載置台、プラズマ処理装置、並びに電極および載置台の製造方法

技術分野

本発明は、電極および載置台、プラズマ処理装置、並びに電極および載置台の製造方法に関する。

発明の背景

一般に、半導体ウエハに対して、エッチング、CVD (Chemical Vapor Deposition) 或いはスパッタリング等の所定の処理を施す枚葉式の処理装置としてプラズマ処理装置が知られている。

この種のプラズマ処理装置においては、半導体ウエハを真空引き可能になされた処理容器内の載置台上に載置して比較的高温下にて、各種の処理を施すが、処理を行なっている間、ウエハを位置ずれしないように保持することが必要であり、このために一般的に静電チャックが用いられている。

ここで従来一般的なプラズマ処理装置について説明する。図11は従来一般的なプラズマ処理装置を示す概略構成図であり、真空引き可能になされた処理容器2内には、下部電極を兼ねる載置台4が設置されている。この載置台4は、例えばシースヒータのような加熱ヒータ6が絶縁状態で埋設されている。具体的には、上記加熱ヒータ6を例えばアルミニウム等により鑄込むことによりこれを埋設している。そして、このアルミニウム製の載置台4の上面に、静電チャッキング用のチャック電極をセラミックス材に埋設してなるセラミック製の静電チャック8を接着剤により接合して設けており、この上面に半導体ウエハWを静電力により吸着保持するようになっている。

また、処理容器2の天井部には、上記載置台4と対向させて上部電極10が設けられている。この上部電極10内にも、例えばシースヒータのような加熱ヒータ12が、アルミニウム等により鑄込むことにより埋設されている。そして、この上部電極10に、プラズマ発生用の高周波電圧を印加するための高周波電源1

4が接続されており、この上部電極10と下部電極である載置台4との間にプラズマを発生させてウエハWに対して所定の処理を施すようになっている。

ところで、半導体ウエハの処理温度が比較的低い場合、例えば処理温度が略200℃以下の場合にはそれ程問題は生じなかったが、成膜速度等の処理速度を上げるためや膜質の改善のために、処理温度を、例えば300～400℃程度まで上昇させることが要請されてきている。

このような高温域になると、例えば上記上部電極10に関しては、処理時の昇降温による熱伸縮量、熱応力がかなり大きなものとなり、これに起因して電極自体に反りや撓みが発生してプラズマ発生用の高周波伝播が不均一になるなどの問題が発生する場合があった。また、この上部電極10の下面にガス供給用のシャワーヘッド部を密接して取り付けする場合もあるが、上記した理由によりこのシャワーヘッド部に割れが発生する場合もあった。

また、載置台4に関しては、接着剤の耐熱限度を超えて静電チャック8が剥がれたり、或いは上記したような熱伸縮、熱応力の発生に伴って反りや撓みが発生する外に、載置台4を構成するアルミニウムと静電チャック8を構成するセラミックスとの線膨張係数の差に起因して、静電チャック8自体が割れてしまうなどの問題も発生する場合があった。

特に、ウエハサイズが6インチ、8インチから12インチへと大型化するに従って、熱伸縮量もその分大きくなり、上記した問題点の早期解決が望まれている。

発明の開示

本発明は、以上のような問題点に着目し、これを有効に解決すべく創案されたものであり、本発明の第1の目的は、電極の反りや撓みの発生を抑制することにある。

本発明の第2の目的は、静電チャックに剥がれや割れが発生しない載置台を提供することにある。

上記第1の目的を達成するため、本発明による電極は、面状に配置された加熱ヒータと、この加熱ヒータを上下より挟み込むように配置されたセラミックス金属複合体とを母材金属で鋳込んで形成される。セラミックス金属複合体により電

極が補強され、反りや撓みの発生が抑制される。

また、本発明による電極は、面状に配置された加熱ヒータと、この加熱ヒータの配置面と略平行に加熱ヒータと並んで設けられた芯金板とを母材金属で鋳込んで形成される。このため、芯金板により電極が補強され、反りや撓みの発生を抑制することが可能となる。芯金板には、複数の母材金属連通孔を形成することが好適である。こうすれば母材金属連通孔を介して母材金属が結合されるので、電極全体の強度を一層向上させることが可能となる。

電極には、母材金属の下面に、ガスを供給するためのシャワーヘッド部が設けられていてもよい。この場合も、上述のように電極自体に反りや撓みが発生しにくいいため、シャワーヘッド部の割れや剥がれを防止することができる。

電極には高周波電圧を印加することができ、この場合には、電極の歪みが抑制されているため高周波を均一に伝播させることが可能となる。

更に、上記第2の目的を達成するため、本発明は、面状に配置された加熱ヒータと、この加熱ヒータを上下より挟み込むように配置された上側及び下側セラミックス金属複合体と、上側セラミックス金属複合体と線膨張係数が略同一になされ、上側セラミックス金属複合体の上面に接合された、被処理体を吸着保持するためのセラミックス製の静電チャックとを備えた載置台を提供する。かかる構成によれば、上側及び下側セラミックス金属複合体により載置台全体が補強されて反りや撓みが抑制されるのみならず、上側セラミックス金属複合体と静電チャックの線膨張係数が略同じに設定されているので、両者間での熱伸縮量に差がほとんど生ぜず、静電チャックが剥がれたり割れたりすることを防止することが可能となる。

加熱ヒータと上側及び下側セラミックス金属複合体とは、母材金属により鋳込られていることが好適である。

静電チャック上に載置される被処理体の裏面に伝熱ガスを供給できるように載置台を構成することも好適である。

上側セラミックス金属複合体と静電チャックとは、ろう付け、鍛圧接合および接着等の手法により接合することができる。

載置台には、高周波電圧を加えることができ、この場合には、載置台の歪みが

抑制されているため高周波を均一に伝播させることが可能となる。

上述した特徴を有する電極および／または載置台を用いてプラズマ処理装置を構成することができる。この場合、電極または載置台の熱伸縮に伴う変形を抑制できるので、高温処理時にも安定して面内均一性の高い処理を行なうことができる。

電極および／または載置台は、鋳型内に加熱ヒータと多孔質セラミックスを配置し、鋳型内に溶融した母材金属を流し込んで多孔質セラミックスおよび加熱ヒータを母材金属中に鋳込むことにより製造することが好適である。この製法によれば、鋳込み過程において多孔質セラミックスに母材金属が含浸されてセラミックス金属複合体が形成される。そして、加熱ヒータを取り囲む金属とセラミックス金属複合体を構成する金属とが連続した金属相になり、電極或いは載置台の強度を向上させることが可能となる。

図面の簡単な説明

図 1 は発明の一態様としてのプラズマ処理装置を示す構成図である。

図 2 は図 1 中の上部電極の製造方法を説明するための説明図である。

図 3 は Al-SiC 複合体中の SiC、Al の含有率（体積百分率）と線膨張係数との関係を示すグラフである。

図 4 は本発明の電極の変形例を示す概略断面図である。

図 5 は本発明の電極の他の実施例を示す概略断面図である。

図 6 は芯金板を示す平面図である。

図 7 は本発明の載置台の変形例を示す概略断面図である。

図 8 は載置台の静電チャックの接合の変形例を示す図である。

図 9 は載置台の静電チャックの接合の他の変形例を示す図である。

図 10 は載置台の他の変形例を示す図である。

図 11 は従来一般的なプラズマ処理装置を示す概略構成図である。

好適な実施形態の説明

以下に、本発明に係る電極、載置台、プラズマ処理装置及びこれらの製造方法

の一実施例を添付図面に基づいて詳述する。

図1の発明の一態様としてのプラズマ処理装置を示す構成図、図2は図1中の上部電極の製造方法を説明するための説明図、図3はアルミニウム中のSiCの含有量と線膨張係数との関係を示すグラフである。

図1に示すように、このプラズマ処理装置20は、例えばアルミニウムよりなる円筒体状の処理容器22を有しており、この側部には被処理体である半導体ウエハWを処理容器22内へ搬入搬出する際に開閉されるゲートバルブ34が設けられると共に、底部には、図示しない真空ポンプ等を介設した真空排気系に接続された排気口36が設けられており、処理容器22内を真空引き可能としている。この処理容器22の内部には、被処理体である半導体ウエハWを載置して保持するための載置台24が設けられている。この載置台24は、下部電極としても機能するものである。この載置台24は、載置台本体26とこの上面に接合される静電チャック28とよりなり、この載置台本体26の下部より下方に延びる支持部30は、処理容器22の底部に対して絶縁部材32を介して貫通して設けられており、これにより、載置台24の全体を支持している。

この載置台本体26には、内部に直径が10mm程度の例えばシースヒータ等を渦巻状に巻回してなる平面状の下側加熱ヒータ38が埋め込まれて設置されている。この下側加熱ヒータ38は、例えばニッケル・クロム合金よりなる中心部の発熱体38Aとこの周囲を被う例えばマグネシア(Mg₂O₃)よりなる絶縁体38Bにより構成されている。

そして、この加熱ヒータ38を上下より挟み込むように載置台用の上側セラミックス金属複合体40Aと下側セラミックス金属複合体40Bが配置して設けられており、全体は純粋なアルミニウム金属により被われている。これらのセラミックス金属複合体40A、40Bは、例えばアルミニウム等の金属と、セラミックス、例えばSiC(炭化珪素)、AlN(窒化アルミ)、Al₂O₃(アルミナ)等との複合体である。この場合、アルミニウムとセラミックスとの混合比を適宜選択することにより、一定の範囲内で所望の線膨張係数のセラミックス金属複合体40A、40Bに設定されている。

そして、この上側セラミックス金属複合体40Aの上面はアルミニウムに被わ

れることなく露出されており、この表面に、半導体ウエハWを吸着保持するためのセラミック製の上記静電チャック28が耐熱性に優れる例えばアルミニウムろう剤44により接合されている。この場合、板、箔状、ペースト状或いは粉末状のろう剤を用いればよい。この静電チャック28は、チャック電極46をセラミック材により埋設することにより形成されており、このセラミック材としてはSiC、AlN、Al₂O₃等を用いることができる。

ここで重要な点は、熱伸縮量の差を吸収するために上記静電チャック28の線膨張係数と上記載置台用の上側セラミックス金属複合体40Aの線膨張係数とが略同一になるように設定されていることである。

例えば静電チャック28のセラミック材としてAlNを用い、セラミックス金属複合体40AとしてAl-SiC複合体を用いた場合には、AlNの線膨張係数は略 $4.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 程度であるので、上側セラミックス金属複合体40Aの線膨張係数を上記と同じ略 $4.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 程度に設定する。

具体的には、Alの線膨張係数は略 $23.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 程度であり、SiCの線膨張係数は略 $3.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 程度であるので、両者の混合比に応じてAl-SiC複合体の線膨張係数は図3に示すように変化する。従って、複合体の線膨張係数が略 $4.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ にするにはSiCの含有率（体積百分率）を略83%程度に設定する。このような複合体を用いることにより、AlN製の静電チャック28とAl-SiC上側セラミックス金属複合体40Aとの線膨張係数が略同一となるように設定する。尚、下側セラミックス金属複合体40Bの線膨張係数も上記した数値と略同一になるように設定すればよい。

また、他の一例として静電チャック28のセラミックス材として線膨張係数が略 $7.8 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 程度のAl₂O₃を用いた場合には、図3に示すグラフより、SiCの含有率（体積百分率）が略75%のAl-SiC複合体を用いることにより、線膨張係数が同じ $7.8 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ の上側セラミックス金属複合体40Aとすることができる。

上述したような線膨張係数 $4.5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ のセラミックス金属複合体40A、40Bは、以下のようにして作ることができる。例えば図2に示すように所定の内部形状を有する鋳型48内に、巻回された下側加熱ヒータ38と所定の気

一方、上記載置台 24 に対向する処理容器天井部には、上部電極 70 が設けられている。具体的には、この上部電極 70 は上述した下部電極である載置台 24 と略同様な内部構造をしており、上部電極 70 には、内部に直径が 10 mm 程度の例えばシースヒータ等の渦巻状に巻回してなる平面上の上側加熱ヒータ 72 が埋め込まれている。この上側加熱ヒータ 72 も例えばニッケル・クロム合金よりなる中心部の発熱体 72A とこの周囲を被うように例えばマグネシア (Mg_2O_3)

よりなる絶縁体 7 2 B により構成されている。

そして、この加熱ヒータ 7 2 を上下より挟み込むように厚さが共に 5 ～ 1 0 m m 程度の上部電極用の上側セラミックス金属複合体 7 4 A と下側セラミックス金属複合体 7 4 B が配置して設けられており、全体は純粋なアルミニウム金属により被われている。

これらのセラミックス金属複合体 7 4 A、7 4 B も、先の複合体 4 0 A、4 0 B と同様に、アルミニウム等の金属とセラミックス、例えば S i C、A l N、A l₂O₃ 等との複合体である。このセラミックス金属複合体 7 4 A、7 4 B の製造方法も、先に図 2 で説明したような含浸法を用いることができる。そして、上記上側加熱ヒータ 7 2 にはリード線 8 2 を介して加熱用電力を投入できるようになっている。

この上部電極 7 0 は、絶縁部材 7 6 を介して容器天井部に取り付け支持されており、この上部電極 7 0 には、マッチング回路 7 8 を介して、例えば 1 3 . 5 6 M H z の高周波を発生するプラズマ発生用高周波電源 8 0 が接続されている。

また、この上部電極 7 0 の下部には、例えばアルミニウム製のシャワーヘッド部 8 4 が図示しないネジ等により接合されており、このシャワーヘッド部 8 4 の下面は、多数のガス孔 8 6 を有するシリコン製のガス噴射面 8 8 として形成されて、このガス孔 8 6 より処理空間に向けて所定のガスを供給し得るようになっている。

次に、以上のように構成された本実施例の動作について説明する。

まず、図示しない搬送アームに支持された未処理の半導体ウエハ W を、開放されているゲートバルブ 3 4 を介して処理容器 2 2 内へ搬入し、これを載置台 2 4 上に載置し、直流電圧源 6 0 を ON とすることにより発生する静電チャック 2 8 の吸着力によりウエハ W を吸着保持させる。

次に、上部電極 7 0 の上側加熱ヒータ 7 2 及び載置台 2 4 の下側加熱ヒータ 3 8 によりウエハ W を所定のプロセス温度まで昇温し、そして、上部電極 7 0 の下面に設けたシャワーヘッド部 8 4 のガス孔 8 6 から例えば S i H₄、S i F₄、酸素等の成膜ガスを流量制御しつつ処理空間へ導入する。そして、処理容器 2 2 内を所定のプロセス圧力に維持すると共に、1 3 . 5 6 M H z のプラズマ発生用高

周波電圧を上部電極 70 に印加すると共に、載置台 24 にはバイアス用高周波電圧を印加する。

上記プラズマ発生用の高周波電圧を上部電極 70 に印加することにより、プラズマ化されて活性化された成膜ガスが反応し、ウエハ表面に例えば SiOF 等の成膜を施すことになる。

ここで、プロセス温度は、従来のプロセス温度よりも高い 300～400℃程度的高温域で行なわれるので、プロセスの繰り返しにより上部電極 70 及び載置台 24 には、大きな繰り返し熱応力が付加されることになる。

この場合、上部電極 70 に関しては、上側加熱ヒータ 72 を挟むようにして上部電極用の上下側セラミックス金属複合体 74A、74B により鑄込まれているので、この上部電極 70 の全体の強度が増しており、この上部電極 70 に反りや撓みが発生することを防止することができる。特に、加熱ヒータ 72 を挟んで 2 枚の複合体 74A、74B を埋め込んでいることから、それぞれが同等の寸法で熱伸縮するので上部電極 70 の厚み方向に大きな熱応力がかかることもなく、この点より反りや撓みの発生を大幅に抑制することが可能となる。

従って、上部電極 70 の歪みに起因して発生していた高周波伝播の不均一性もなくすることができ、均一なプラズマを生成することが可能となるばかりか、シャワーヘッド部 84 の割れも防止することが可能となる。

一方、載置台 24 に関しては、この場合にも、下側加熱ヒータ 38 の上下側を載置台用の上下側セラミックス金属複合体 40A、40B により挟み込むようにしたので、載置台 24 自体の強度を向上させることができ、その結果、熱伸縮に伴って熱応力が発生してもこの反りや変形等を防止することが可能となる。特に、セラミック製の静電チャック 28 とこれが接合される上側セラミックス金属複合体 40A との線膨張係数が略同じになるように設定されているので、昇降温に伴って両者が熱伸縮してもその熱伸縮量は略同じになるので、両者間に大きな熱応力が加わることを防止でき、従って、静電チャック 28 が割れたり、剥がれたりすることを防止することができる。

また、この静電チャック 28 は、耐熱性の高いろう剤により上側セラミックス金属複合体 40A の表面に接合されているので、300～400℃程度的高温処

理にも耐えることができ、この点よりも、静電チャック 28 が剥がれることを防止することができる。

また、セラミックス金属複合体を内部に埋め込んだ載置台 24 や上部電極 70 は、図 2 を用いて説明したように、含浸法により加熱ヒータも含めて一気に作ることができるので、簡単に且つ容易に工程数も少なく製造することが可能である。

尚、上記実施例では、上部電極 70 においては、上下側セラミックス金属複合体 74A、74B 間を、上側加熱ヒータ 72 の直径よりも僅かに大きな距離だけ離間させた状態で埋め込んだが、これに限定されず、図 4 に示すように両複合体 74A、74B を接合したような状態とし、上側加熱ヒータ 72 を複合体内に完全に埋め込むようにしてもよい。この場合には、両複合体 74A、74B の間に A1 が略単独では存在しない状態となるためこの部位での熱応力の発生はより抑制可能となるので、この部位の反りや撓みを一層抑制することができる。

また、上部電極 70 内に上記した複合体 74A、74B を一切設けず、図 5 及び図 6 に示すように、厚さが 1～2mm 程度の非常に薄い剛性の高い円板状の芯金板 90 を上側加熱ヒータ 72 と平行に並べて埋め込んでもよい。図 6 は芯金板 90 の平面図であり、この芯金板 90 は、母材金属であるアルミニウムより軟化点が高く剛性も高い例えばステンレス等の金属板を用いる。そして、この芯金板 90 には、直径が 0.1～1.0mm 程度の多数の母材金属連通孔 92 が形成されており、従って、熔融アルミニウムで鑄込むと、この連通孔 92 を介して上下のアルミニウムが結合することになる。

この実施例の場合にも、芯金板 90 により上部電極 70 が補強されるので、この反りや撓みの発生を抑制することが可能となる。

また、この場合、芯金板 90 と母材金属のアルミニウムとの線膨張率係数が異なることから、両者の界面が剥離することも考えられるが、母材金属連通孔 92 を介して上下のアルミニウムが結合しており、しかも芯金板 90 は非常に薄くて与える熱伸縮の影響は非常に少ないので、芯金板 90 と母材金属のアルミニウムの界面が剥離することもない。また、この芯金板 90 は、熱伝導性も良好なので、上部電極 70 を迅速に加熱することもできる。

また、この芯金板 90 は、上側加熱ヒータ 72 を挟み込むようにこの上下に 2

枚設けるようにしてもよい。これによれば、上部電極 70 の上部側と下部側との熱伸縮差を小さくできるので、発生する熱応力をより抑制することができる。

また、上記実施例の載置台 24 においては、上下側セラミックス金属複合体 40 A、40 B 間を、下側加熱ヒータ 38 の直径よりも僅かに大きな距離だけ離間させた状態で埋め込んだが、これに限定されず、図 7 に示すように両複合体 40 A、40 B を接合したような状態として、下側加熱ヒータ 38 を複合体内に完全に埋め込むようにしてもよい。

この場合には、両複合体 40 A、40 B の間に Al が略単独では存在しない状態となるため、この部位での熱応力の発生はより抑制可能となるので、この部位の反りや変形を一層抑制することができる。また、上側セラミックス金属複合体 74 A とセラミックス製の静電チャック 28 とを接合するろう剤としては、Al 系の他に、AlSi 系、AlSiGe 系、AlSiMg 系及び AlSiGeMg 系等を用いることができ、特に、Ge や Mg を含むものは、表面の濡れ性を改善できるので、両者の接合力を一層向上させることができる。

更には、ろう付けする際に、図 8 に示すように厚さ 1 ～ 2 mm 程度のクラッド層 94 を用いてろう付けを行なうようにしてもよい。この場合には、厚さが 10 ～ 100 μ m 程度の非常に薄いクラッド膜を多層に設けたクラッド層 94 を用い、例えばアルミニウム金属を主体とする AlSiGeMg 系ろう剤を使用する場合には、クラッド層 94 の中心にアルミニウム膜を介在させ、その両側に行くに従って、Al と Si の混合比を同じような傾向で徐々に変えたクラッド膜を形成して線膨張率に傾斜を持たせ、上下の最外側を被うクラッド膜の線膨張率をセラミックス製の静電チャック 28（上側セラミックス金属複合体 40 A）の線膨張率と略一致させるようにすればよい。これによれば、クラッド層 94 の熱伸縮も吸収することができるので、この場合にも静電チャック 28 と複合体 40 A の接合強度を劣化させることがなく、両者を強固に結合することができる。

また、上記した両者の接合は、前述したようなろう付けに限定されず、鍛圧接合（接合を必要とする部材の外周部上から、部分加圧して局部的に圧縮を加えると共に、外周部にメタル流動を生じさせて接合させる技術）するようによい。この鍛圧接合では図 9 に示すように、例えば真空容器中で静電チャック 28

の下面と載置台本体 26 の上側セラミックス金属複合体 40 A の上面に、スパッタにより活性アルミニウム層 96、98 を付着させ、この状態で両者を圧接して接合させる。

また、他の方法として大気中で溶射等により上記活性アルミニウム層 96、98 を付着させ、この場合は直ちにアルミニウム表面が酸化して活性が劣化するので、その後は、活性アルミニウム層 96、98 の表面に自然に形成された薄い酸化膜を真空容器中で除去して活性面を出し、この状態で両者を圧接すればよい。

このように、鍛圧接合を行なう場合には、種々の金属を含むろう剤とは異なり、アルミニウムのみを用いているので、ウエハに対して重金属汚染が発生することを防止することができる。

なお、プラズマ処理装置のプロセス温度に適合した耐熱温度を有するのであれば、静電チャック 28 と上側セラミックス金属複合体 40 A の接合を接着剤によって行ってもよい。接着剤としては、シリコン系接着剤およびエポキシ系接着剤等の樹脂系接着剤や、セラミック系接着剤を用いることができる。なお、接着剤は熱伝導性の高いものを用いることが好ましい。

なお、上記の実施形態においては、加熱ヒータとして抵抗加熱を利用する電気ヒータが用いられているが、これには限定されない。例えば、熱媒を通すことが可能な管により加熱ヒータを構成してもよい。この場合も、管は鑄込みにより載置台または電極の内部に容易に埋め込むことができる。

更に、図 10 に示すように、静電チャックとウエハとの間に伝熱ガスを供給できるように載置台を構成してもよい。この場合、まず、図 1 に示す載置台 24 を製造する場合と同様にして、上側セラミックス金属複合体 40 A、下側セラミックス金属複合体 40 B および加熱ヒータ 38 をアルミニウムで鑄込む。

次いで、上側セラミックス金属複合体 40 A の上面に拡散室 100 を機械加工により形成する。拡散室 100 は、図 10 の (b) に示すように、同心円状に配置された複数の円周溝と、各円周溝間を連通する径方向溝とを組み合わせで形成する（なお、図 10 の (b) は図 10 の (a) の矢印 B 方向から見た載置台の平面図である）。

次いで、拡散室 100 の溝底を起点とし載置台本体 26 を貫通して載置台本体

26の下面に開口する伝熱ガス通路102を、載置台本体26を穿孔することにより形成する。なお、このとき、伝熱ガス通路102は、加熱ヒータ38のある位置を避けて設けられる。

次に、静電チャック28を載置台本体26にろう付けする。その後、静電チャック28の複数箇所に伝熱ガス供給孔104を穿孔する。なお、伝熱ガス供給孔104が予め形成された静電チャック28を載置台本体26にろう付けしてもよい。

図10に示す載置台24が適用されたプラズマ処理装置で成膜処理等の処理を行う場合には、伝熱ガス通路102の下端側に、ArガスまたはHeガス等の伝熱ガスが、ガス供給源（図示せず）から供給される。伝熱ガス通路102を通過した伝熱ガスは、拡散室100を経て、伝熱ガス供給孔104からウエハ裏面に向けて供給される。

図10に示す実施例によれば、伝熱ガスがウエハの裏面に均一に供給されるため、載置台24からウエハに均一かつ高効率で熱を伝達することができる。このため、プロセスの面内均一性を向上させることができる。

なお、上側セラミックス金属複合体40Aの上面に溝を形成することに代えて、静電チャック28の下面に溝を形成することにより、拡散室100を形成してもよい。

なお、これまで説明してきた各実施例においては、プラズマ処理として成膜を行なうプラズマCVD処理を例にとって説明したが、これに限定されず、スパッタ処理、エッチング処理、アッシング処理等にも本発明装置を適用できるのは勿論である。

更には、プラズマ発生用の周波数も先に説明したものに限定されない。また、被処理体としては、半導体ウエハに限定されず、LCD基板、ガラス基板等も用いることができる。

請 求 の 範 囲

1. 面状に配置された加熱ヒータと、
前記加熱ヒータを上下より挟み込むように配置されたセラミックス金属複合体と、
前記加熱ヒータおよび前記セラミックス金属複合体が鋳込まれた母材金属と、
を備えたことを特徴とする電極。
2. 面状に配置された加熱ヒータと、
前記加熱ヒータの配置面と略平行に前記加熱ヒータと並んで設けられた芯金板と、
前記加熱ヒータおよび前記芯金板が鋳込まれた母材金属と、を備えたことを特徴とする電極。
3. 前記芯金板には、複数の母材金属連通孔が形成されていることを特徴とする、請求項2に記載の電極。
4. 前記母材金属の下面には、ガスを供給するためのシャワーヘッド部が設けられていることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電極。
5. 前記電極に高周波電圧が印加されることを特徴とする、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の電極。
6. 面状に配置された加熱ヒータと、
前記加熱ヒータを上下より挟み込むように配置された上側及び下側セラミックス金属複合体と、
前記上側セラミックス金属複合体と線膨張係数が略同一になされ、前記上側セラミックス金属複合体の上面に接合された、被処理体を吸着保持するためのセラミックス製の静電チャックと、
を備えたことを特徴とする載置台。
7. 前記加熱ヒータと前記上側及び下側セラミックス金属複合体とが鋳込まれる母材金属を更に備えたことを特徴とする、請求項6に記載の載置台。
8. 前記上側セラミックス金属複合体と前記静電チャックとはろう付けされていることを特徴とする、請求項6または7に記載の載置台。

前記処理用器内に配置された載置台であって、面状に配置された加熱ヒータと、前記加熱ヒータを上下より挟み込むように配置された上側及び下側セラミックス金属複合体と、前記上側セラミックス金属複合体と線膨張係数が略同一になされ、前記上側セラミックス金属複合体の上面に接合された、被処理体を吸着保持する

ためのセラミックス製の静電チャックと、を有する載置台と、

前記載置台に高周波電圧を印加する高周波電源と、
を備えたことを特徴とするプラズマ処理装置。

17. 前記加熱ヒータおよび前記上側及び下側セラミックス金属複合体が母材金属に鑄込まれていることを特徴とする、請求項16に記載のプラズマ処理装置。

18. 前記静電チャックの表面に伝熱ガスを供給する伝熱ガス供給路が前記載置台を貫通して設けられていることを特徴とする、請求項16または17に記載のプラズマ処理装置。

19. 前記上側セラミックス金属複合体と前記静電チャックとはろう付けされていることを特徴とする、請求項16乃至18のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置。

20. 前記上側セラミックス金属複合体と前記静電チャックとは鍛圧接合されていることを特徴とする、請求項16乃至18のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置。

21. 前記上側セラミックス金属複合体と前記静電チャックとは接着されていることを特徴とする、請求項16乃至18のいずれか一項に記載のプラズマ処理装置。

22. 加熱ヒータが多孔質セラミックスにより上下より挟み込まれるような位置関係で、鑄型内に前記加熱ヒータおよび前記多孔質セラミックスを配置する工程と、

前記鑄型内に溶融した母材金属を流し込み、前記多孔質セラミックスおよび前記加熱ヒータを母材金属中に鑄込むとともに、前記多孔質セラミックスに前記母材金属を含浸させることによってセラミックス金属複合体を形成する工程と、
を備えたことを特徴とする電極の製造方法。

23. 加熱ヒータが多孔質セラミックスにより上下より挟み込まれるような位置関係で、鑄型内に前記加熱ヒータおよび前記多孔質セラミックスを配置する工程と、

前記鑄型内に溶融した母材金属を流し込み、前記多孔質セラミックスおよび前



要 約 書

載置台 24 は、面状に配置された下側加熱ヒータ 38 と、加熱ヒータ 38 を上下より挟み込むように配置された上側及び下側セラミックス金属複合体 40A、40B と、上側セラミックス金属複合体 40A の上面に接合され被処理体 W を吸着保持するセラミックス製の静電チャック 28 とを含んで構成される。上側セラミックス金属複合体 40A と静電チャック 28 の線膨張係数はほぼ同一とされており、これにより両者の熱伸縮量の差に起因した静電チャック 28 の剥がれや割れの発生を防止できる。